静電型 MEMS エネルギーハーベスタにおける非線形発振の検討(1)

Nonlinear Oscillation for an Electrostatic MEMS energy harvester (1)

^O小野 一善¹、1- 7ν 7 $^{+}$ 、 $^{+,2}$ 、佐藤 昇男³、田中 雄次郎¹、阪田 知巳³、神 好人^{1,3}、

小泉 弘¹(1.日本電信電話株式会社 NTT 先端集積デバイス研究所、2.ジョージ7工科大学、

3. 日本電信電話株式会社 NTT デバイスイノベーションセンタ)

[°]K. Ono¹, A. Yu^{1,2}, N. Sato³, Y. Tanaka¹, T. Sakata³, Y. Jin^{1,3}, and H. Koizumi¹ (1. NTT Device

Technology Labs, NTT Corporation, 2. Georgia Institute of Technology, and 3. NTT Device

Innovation Center, NTT Corporation) E-mail: ono.kazuoyoshi@lab.ntt.co.jp

【1.はじめに】

IOT(Internet Of Things)デバイスなどを主と したセンサネットワーク端末の自立動作へ向 けて[1]、環境振動による Energy harvesting が提 案され、活発に研究がなされている[2]。我々 は、静電誘導方式を用いた小型な Energy harvester の実現に向けて、Slit-and-slider 構造 (Fig.1)を用いた MEMS Energy harvester を提 案してきた[3-5]。このような Energy harvester にとっての最大の課題の一つとして、限られた サイズで発電量を向上することが挙げられる。 発電量を向上させるアプローチとして、非線形 現象を利用し、振動子の振幅を増大する手法が 既に提案されている[6, 7]。今回、我々は上述 した Slit-and-slider 構造において、非線形効果 の発現を検討したので、報告する。

【2. 原理】

Harvester のバネ - 質量系を一次元自由振動 子と仮定した場合、振動子の規格化方程式は、 Duffing 方程式として、

 $x'' + 2\zeta x' + (1 - r)x + \delta x^3 = -z''.$

のように記述される[7]。この式より、系が強 く励振された場合、非線形現象が発生すること がわかる。このような振る舞いを系に生じさせ るためには、バネ材料の選定が重要となる。今 回、我々は、そのバネ材料として、金(Au)を用 いて構造作製を行なった。



Fig.1. A basic components of slit-and-slider

structure.

【3. 実験結果】

金めっきを用いた Seamless integration 技術 [8]にて作製した MEMS 構造体(可動部サイ ズ:1mm²×25 μm)に対して、振幅が75 V で ある AC 電圧を印加することで可動部を励振 し、その変位を測定した(Fig.2)。AC 電圧の 周波数が可動構造の共振周波数に近づくにつ れて、変位が増大している。加えて、変位がピ ーク点に到達した後、急激に減少しており、一 般的な線形発振の周波数応答とは異なること がわかる。この現象は、非線形ハードスプリン グ効果に由来すると推定される。以上より、今 回のAu めっきを材料として作製した構造によ り、非線形発振の可能性が示唆された。

【参考文献】 [1] R. Negishi, et. al.: Proc. APCC2014, p. 412, Oct., 2014. [2] 小西等:第62 回応用物理学会春季学術講演会、11p-A29-5, 2015 [3] K. Ono, et. al.: Proc. IEEE Transducers 2011, p. 1863, June, 2011. [4] N. Sato, et. al.: J. Microelectromech. Syst. vol.21, no.5, p.1218, 2012. [5] 森村等:電子情報通信学会論文誌. C, エレ クトロニクス、Vol. J95-C, No.8, p. 175, 2012. [6] F. Cottone, et. al.: Phys. Rev. Lett., vol. 102, pp.080601, 2009. [7] R. L. Harne, et. al.: Smart Mater. Struct., vol. 22, no.2, p. 1, 2013. [8] H. Ishii, et. al.: Proc. SPIE 4230, p. 43, 2000.



Fig.2. Displacement for the frequency response.